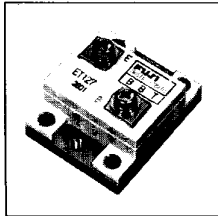


パワートランジスタ Power Transistor

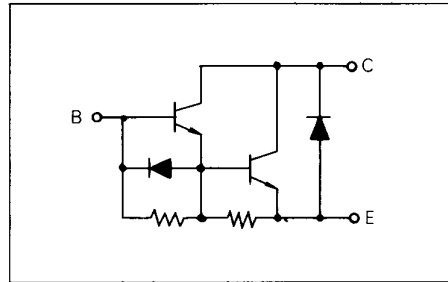
ET127



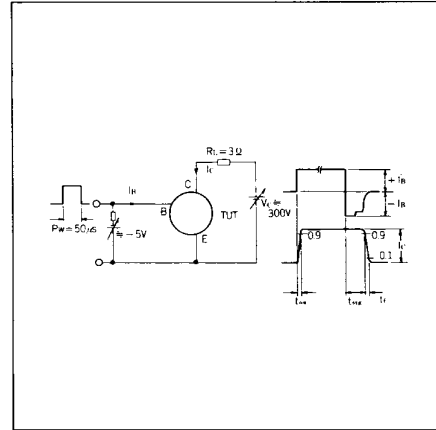
600V
100A
770W

■等価回路図

Equivalent Circuit Schematic



※Switching Time Test Circuit

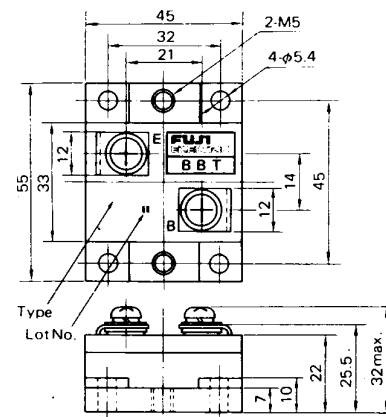


■定格と特性：Maximum Ratings and Characteristics

●絶対最大定格：Absolute Maximum Ratings

Items	Symbols	Ratings	Units
コレクタ・ベース間電圧	Vcbo	600	V
コレクタ・エミッタ間電圧	Vceo	600	V
コレクタ・エミッタ間電圧	Vceo(sus)	450	V
エミッタ・ベース間電圧	Vebo	6	V
コレクタ電流	DC	Ic	100 A
	1ms	Ic	250 A
	DC	-Ic	100 A
ベース電流	DC	Ib	5 A
	1ms	Ib	15 A
コレクタ損失	one Transistor	Pc	770 W
	two Transistor	Pc	-
接合部温度	Tj	+150	°C
保存温度	Tstg	-40~+125	°C
重量	m	200	g
絶縁耐圧	AC.1min	Viso	-
締付けトルク	Mounting	25±5	kg・cm
	Terminals	M5: 25±5	kg・cm

■外形寸法：Outline Drawings



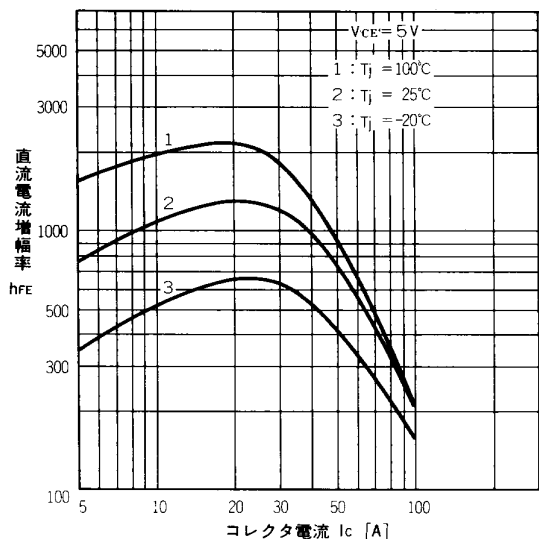
●電気的特性：Electrical Characteristics (Tj=25°C)

Items	Symbols	Test Conditions	Min	Typ	Max	Units
コレクタ・ベース間電圧	Vcbo	Icbo=1mA	600			V
コレクタ・エミッタ間電圧	Vceo	Iceo=1mA	600			V
コレクタ・エミッタ間電圧	Vceo(sus)	Ic=1A	450			V
	VceX(sus)		-			V
エミッタ・ベース間電圧	Vebo	IeBo=300mA	6			V
コレクタシャ断電流	Icbo	Vcbo=600V			1.0	mA
エミッタシャ断電流	Iebo	Vebo=6V			300	mA
コレクタ・エミッタ間電圧	-Vce	-Ic=80A			1.6	V
直流電流増幅率	hFE	Ic=100A, Vce=5V	100			
コレクタ・エミッタ飽和電圧	Vce(sat)	Ic=100A, Ib=2A			2.0	V
ベース・エミッタ飽和電圧	Vbe(sat)				3.0	V
※)	ton		Ic=100A, Ib1=2A, -Ib2=2A			4.0
スイッチング時間	tstg	RL=3Ω, Pw=50μs			10.0	μs
	tf	Duty≤2%			3.0	μs

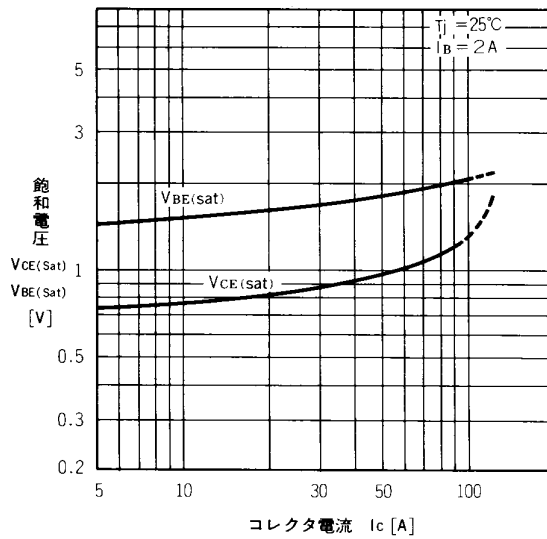
●熱的特性：Thermal Characteristics

Items	Symbols	Test Conditions	Min	Typ	Max	Units
熱抵抗	Rth(j-c)	Transistor			0.13	°C/W
熱抵抗	Rth(j-c)	Diode			0.6	°C/W
熱抵抗	Rth(c-f)	with Thermal Compound		0.05		°C/W

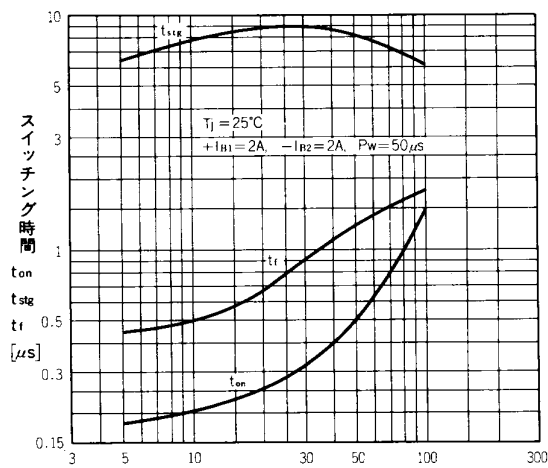
■特性曲線：Characteristics



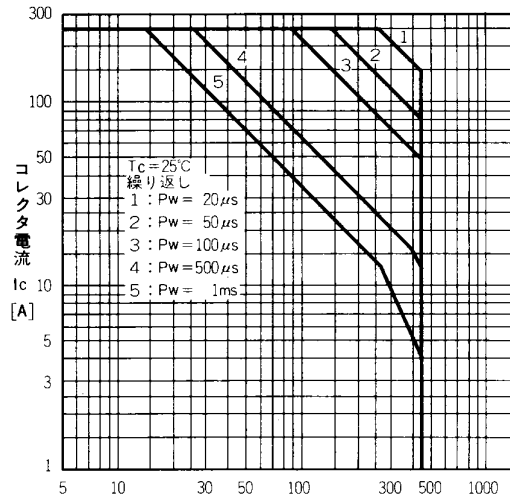
直流電流増幅率－コレクタ電流特性
DC Current Gain



飽和電圧－コレクタ電流特性
Base and Collector Saturation Voltage



スイッチング時間－コレクタ電流特性
Switching Time



安全動作領域特性
Safe Operating Area

